

Medium Power Transistor (32V, 1A)

2SD1664 / 2SD1858

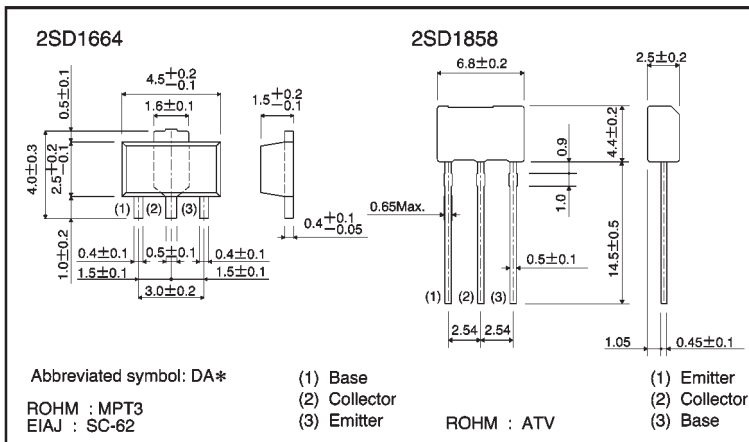
●Features

- 1) Low $V_{CE(sat)}$, $V_{CE(sat)} = 0.15V$ (typical).
($I_c/I_b = 500mA/50mA$)
- 2) Complements the
2SB1132 / 2SB1237.

●Structure

Epitaxial planar type
NPN silicon transistor

●External dimensions (Units: mm)



●Absolute maximum ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Collector-base voltage	V_{CBO}	40	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	32	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	5	V
Collector current	I_c	1	A (DC)
		2	A (Pulse) *1
Collector power dissipation	2SD1664	0.5	W *2
		2SD1858	1
Junction temperature	T_j	150	$^\circ C$
Storage temperature	T_{stg}	-55~+150	$^\circ C$

*1 $P_w=20ms$, $duty=1/2$

*2 When mounted on a 40×40×0.7 mm ceramic board.

*3 When it is mounted on the copper clad PCB (1.7mm thick) with land size for collector 1 square CM or larger.

●Electrical characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Collector-base breakdown voltage	BV _{CBO}	40	—	—	V	I _c =50 μA
Collector-emitter breakdown voltage	BV _{CEO}	32	—	—	V	I _c =1mA
Emitter-base breakdown voltage	BV _{EBO}	5	—	—	V	I _E =50 μA
Collector cutoff current	I _{cBO}	—	—	0.5	μA	V _{CB} =20V
Emitter cutoff current	I _{EBO}	—	—	0.5	μA	V _{EB} =4V
DC current transfer ratio	h _{FE}	82	—	390	—	V _{CE} =3V, I _c =100mA
Collector-emitter saturation voltage	V _{CE(sat)}	—	0.15	0.4	V	I _c /I _B =500mA/50mA
Transition frequency	f _r	—	150	—	MHz	V _{CE} =5V, I _E =-50mA, f=100MHz
Output capacitance	C _{ob}	—	15	—	pF	V _{CB} =10V, I _E =0A, f=1MHz

●Packaging specifications and h_{FE}

Type	h _{FE}	Package	Taping	
		Code	T100	TV2
		Basic ordering unit (pieces)	1000	2500
2SD1664	PQR	○	—	—
2SD1858	PQR	—	○	—

h_{FE} values are classified as follows :

Item	P	Q	R
h _{FE}	82~180	120~270	180~390

●Electrical characteristic curves

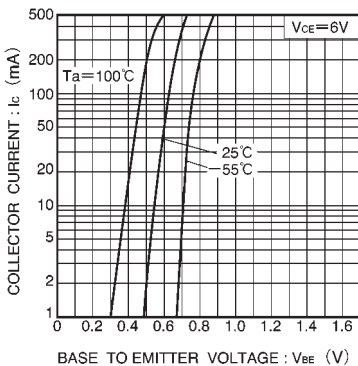


Fig.1 Grounded emitter propagation characteristics

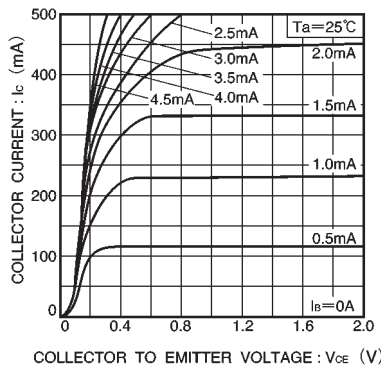


Fig.2 Grounded emitter output characteristics

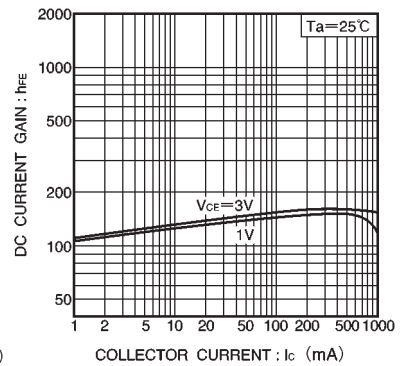


Fig.3 DC current gain vs. collector current (I)

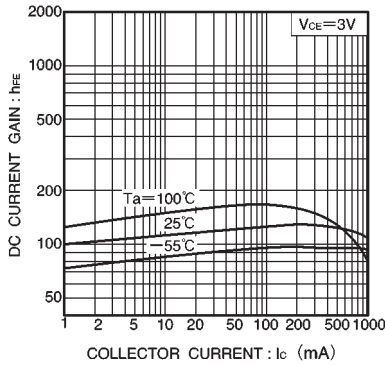


Fig.4 DC current gain vs. collector current (II)

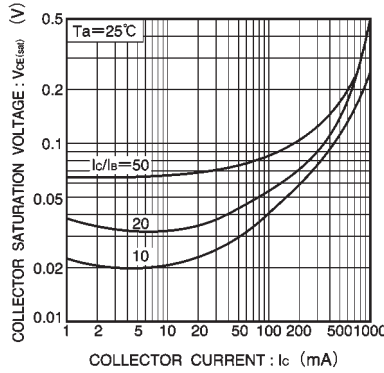


Fig.5 Collector-emitter saturation voltage vs. collector current (I)

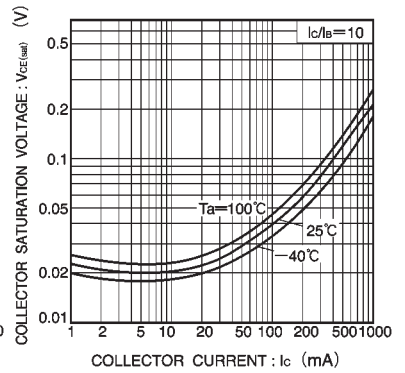


Fig.6 Collector-emitter saturation voltage vs. collector current (II)

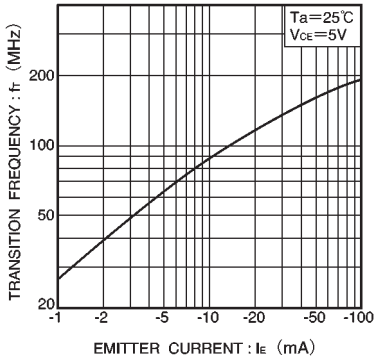


Fig.7 Gain bandwidth product vs. emitter current

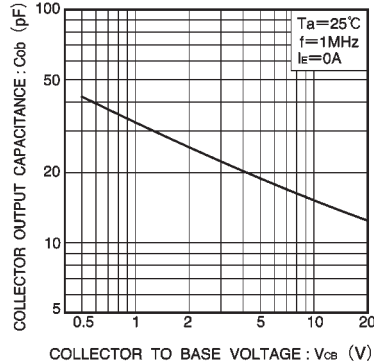


Fig.8 Collector output capacitance vs. collector-base voltage

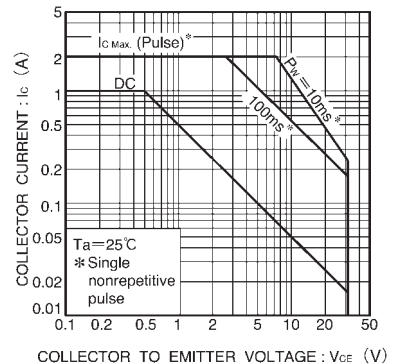


Fig.9 Safe operating area (2SD1664)

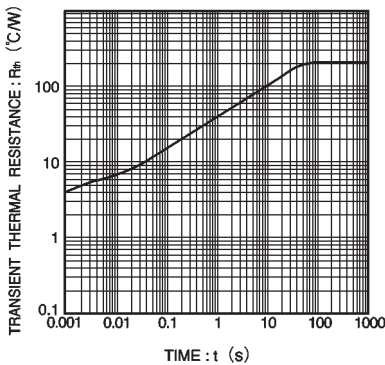


Fig.10 Transient thermal resistance (2SD1664)

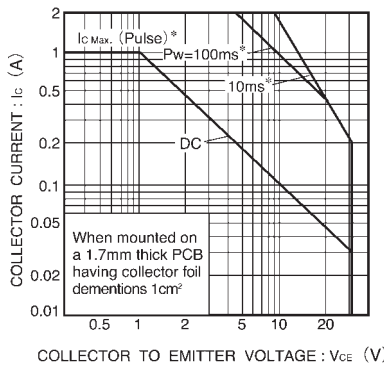


Fig.11 Safe operating area (2SD1858)

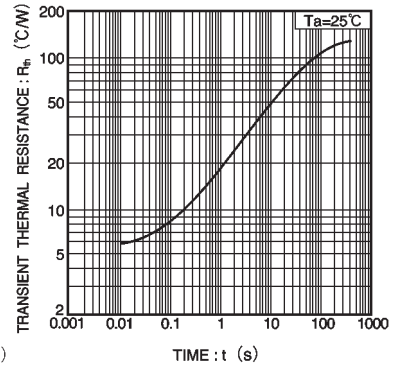


Fig.12 Transient thermal resistance (2SD1858)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331